

# 2SC1079, 2SC1080

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ  
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

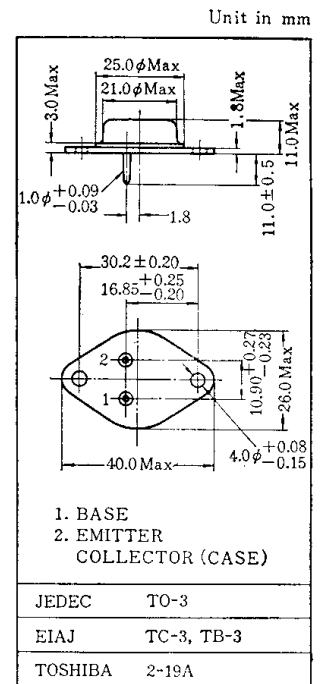
## ○低周波電力増幅用

### ○ Audio Power Amplifier Applications

- コレクタ損失が大きい:  $P_C=100W(T_c=25^\circ C)$
- 高耐圧です:  $V_{CBO}=120V(2SC1079)$   $V_{CBO}=100V(2SC1080)$
- 2SA679/2SA680 とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SA679/2SA680.

### 最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	2SC1079	120	V
	2SC1080	100	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SC1079	120	V
	2SC1080	100	
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	12	A
エミッタ電流	$I_E$	-12	A
コレクタ損失 ( $T_c=25^\circ C$ )	$P_C$	100	W
接合温度	$T_J$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-65~150	$^\circ C$



アクセサリはAC73を適用  
MOUNTING KIT NO. AC73

### 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=50V, I_E=0$	—	—	100	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	100	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SC1079	$I_C=100mA, I_B=0$	120	—	—	V
	2SC1080		100	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	2SC1079	$I_E=-10mA, I_C=0$	5	—	—	V
	2SC1080		5	—	—	
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE}=5V, I_C=2A$	40	—	140	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5V, I_C=10A$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10A, I_B=1A$	—	—	3.0	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=5V, I_C=10A$	—	—	2.5	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE}=5V, I_C=2A$	—	4	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$	—	350	—	pF

Note ;  $h_{FE(1)}$  により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$ , 2SC1079 and 2SC1080 are classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SC1079-R 2SC1080-R	40	80
2SC1079-Y 2SC1080-Y	70	140

